

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2002 年 7 月 11 日 (11.07.2002)

PCT

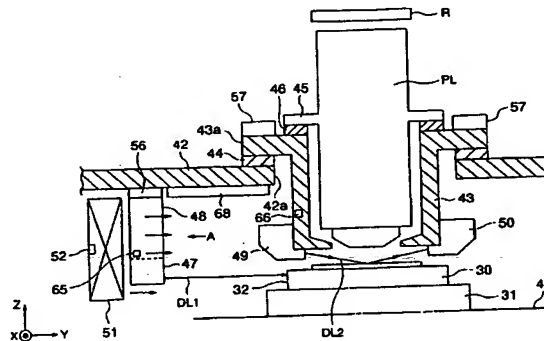
(10) 国際公開番号  
WO 02/054460 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: H01L 21/027 (72) 発明者; および  
(21) 国際出願番号: PCT/JP01/11454 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 神谷 三郎  
(22) 国際出願日: 2001 年 12 月 26 日 (26.12.2001) (KAMIYA, Saburo) [JP/JP]; 〒100-8331 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号 株式会社ニコン 知的財産本部内 Tokyo (JP).  
(25) 国際出願の言語: 日本語 (74) 代理人: 前田 均, 外 (MAEDA, Hitoshi et al.); 〒101-0064 東京都千代田区猿樂町 2 丁目 1 番 1 号 桐山ビル 2 階 前田・西出国際特許事務所 Tokyo (JP).  
(26) 国際公開の言語: 日本語  
(30) 優先権データ:  
特願 2000-397213  
2000 年 12 月 27 日 (27.12.2000) JP (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.  
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社ニコン (NIKON CORPORATION) [JP/JP]; 〒100-8331 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: EXPOSURE DEVICE

(54) 発明の名称: 露光装置



(57) Abstract: An exposure device, comprising a temperature controller (56) installed on a support member (48) for supporting a laser interferometer (47), wherein the temperature of the air blown from a blow hole (51) is measured with a temperature sensor (52) and the temperature of the support member (48) is measured with a temperature sensor (65) to allow the temperature of the blown air to be identical to the temperature of the support member (48), whereby a detection light beam (DL1) from the laser interferometer (47) is suppressed from being swayed on an optical path by the affection of the temperature.

(57) 要約:

レーザ干渉計 (47) を支持する支持部材 (48) に温度調節装置 (56) を取り付け、送風口 (51) から送風される空気の温度を温度センサ (52) で計測するとともに、支持部材 (48) の温度を温度センサ (65) で計測して、送風される空気の温度と支持部材 (48) の温度を一致させるようにして、レーザ干渉計 (47) の検出光 (DL1) の光路上の温度揺らぎの発生を抑制する。

WO 02/054460 A1



(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

## 明 細 書

## 露光装置

技術分野

本発明は、半導体集積回路、液晶表示素子、薄膜磁気ヘッド、撮像素子（CCD等）、その他のマイクロデバイス等を、リソグラフィ技術を用いて製造する際に使用される露光装置に関する。

背景技術

半導体素子等のマイクロデバイスの製造に際しては、マスクとしてのレチクルのパターンを投影光学系を介してフォトリソグが塗布された半導体ウエハやガラスプレート等の感光基板に露光転写するために露光装置が用いられる。

感光基板は、露光処理を実施する前に、投影光学系の光軸に直交する面内でXY方向に位置決めされる。また、感光基板の表面を投影光学系の像面に対して合わせ込むフォーカス調整が行われる。

マスクを載置して移動するレチクルステージや感光基板を載置して移動する基板ステージには、マイクロデバイスの高集積化の進展に伴い、数ナノメートルの位置決め精度が要求されるようになってきている。

このような高精度ステージの位置の計測装置としては、要求される分解能、応答帯域などから、レーザ干渉計（レーザ測長干渉計）を使用するのが一般的である。このレーザ干渉計は、波長安定化されたレーザ光源から射出されたレーザビームをビームスプリッタで2つに分割し、分割された一方のビームをステージに固定された移動鏡（反射鏡）に照射し、他方のビームを投影光学系の鏡筒、又は投影光学系を支持する架台等の固定部分に設置した参照鏡（反射鏡）に照射し、各々反射したビームを干渉させ、その干渉信号からステージの位置を精密に測定するものである。

このレーザ干渉計は、ウエハ又はマスクを載置するテーブルの側面等に設けられた反射鏡にレーザビームを照射する必要があることから、その干渉光学系（レ

ーザ干渉計の構成部分のうち前記反射鏡に対向して配置される部分（以下、この部分をもレーザ干渉計という場合がある。）を設置する位置の設定にはあまり自由度が無く、ステージに対して水平方向に相対する位置に置かざるを得ない。

レーザ干渉計の測定誤差の最大の要因は、レーザビームの光路の屈折率の揺らぎである。特に温度変化による屈折率変動が主要因で、標準空気の場合、1度の温度変化で約1 ppmの屈折率変化が生じる。例えば0.01度の変化があっただけで、300 mmのウェハの両端で3 nmの誤差を生じることになり、問題となってくる。

また、感光基板の表面の投影光学系の像面に対する合わせ込みは、感光基板の表面に斜めに露光光の波長と異なる波長の検出光を照射し、その反射光を光電検出して、その検出結果が所定の基準に一致するように感光基板のZ方向（投影光学系の光軸に沿う方向）の位置及び傾きを自動調整するようにした斜入射光式のフォーカス調整装置（AF装置）を用いて行われる。

このようなAF装置においても、前記レーザ干渉計の場合と同様に、必然的に設置位置に関する自由度は小さく、また、検出光の光路の温度揺らぎによる精度の劣化を回避する必要がある。

このため、従来は、高精度に温度調節された空気（気体）を、レーザ干渉計やAF装置の検出光の光路に送風することにより、検出光の光路上の温度揺らぎの発生を抑制するようにしている。

しかしながら、上述したような検出光の光路の温度揺らぎに伴う屈折率変化は、上述した温度調節された空気の送風によって緩和されるものの、かかる送風気流上には、上述したレーザ干渉計やAF装置を支持するための支持部材が必然的に存在しており、かかる支持部材は、例えば、投影光学系を支持する架台に固定されているため、その架台から該支持部材を介して熱が回り込んでしまい、依然として、検出光の光路に温度揺らぎが生じ、高精度な計測の障害となっている。このため、精度の高いパターン形成が行えない場合があるという問題があった。

## 発明の開示

よって、本発明の目的は、基計測装置の検出光の光路上に温度揺らぎが発生す

ることを十分に防止し、マイクロデバイス等の微細化、高精度化に対応することができる露光装置を提供することである。

以下、この項に示す説明では、本発明を、実施形態を表す図面に示す参照符号に対応つけて説明するが、本発明の各構成要件は、これら参照符号を付した図面に示す部材等に限定されるものではない。

上記目的を達成するための本発明の露光装置は、被計測物体（R，W）に対して計測用の光ビーム（DL1，DL2）を出射して該被計測物体の位置に関する情報を計測する計測装置（27，33）を備えた露光装置において、前記計測装置の光学系（47，49，50）を支持する支持部材（43，48）の温度を調節する温度調節装置（53，56，57，62）を設けたことを特徴とする。

前記温度調節装置としては、前記支持部材に取り付けられる熱交換部材（56，57）と、前記熱交換部材の内部を通過するように温度調節された流体を循環させる循環装置（62）とを有するものを採用することができる。

これらの場合において、前記計測装置の光ビーム（DL1，DL2）の光路を含む空間に温度調節された気体の流れを生成する空調装置（54）を設け、前記空調装置による気体の温度と前記支持部材の温度とが一致するように、前記温度調節装置及び前記空調装置の少なくとも一方を制御することが望ましい。

前記計測装置は、より具体的には、パターンが形成されたマスク（R）又は露光対象としての基板（W）を投影光学系（PL）の光軸に直交する面内で移動するステージ（24，29）の位置を計測するレーザ干渉計（47）であり、あるいは露光対象としての基板の表面の投影光学系の光軸に沿う方向の位置を計測するフォーカスセンサ（49，50）である。

本発明の露光装置によると、支持部材の温度と該支持部材が存在する周辺空間の温度をほぼ一致させることが可能である。従って、露光装置に備わるレーザ干渉計やAF装置等の検出系に当該温度揺らぎによる誤差を生じることが少なくなり、マスクの移動や位置決め、基板の移動や位置決め、あるいは姿勢制御を高い精度で行うことができるようになる。これにより、微細パターンを高精度で転写形成することができ、性能や信頼性の高いマイクロデバイス等を製造することができるようになる。

また、上記目的を達成するための本発明の露光装置は、第1物体(R)に照射される照明光(IL)を第2物体(W)上に投射する投影光学系(PL)を備えた露光装置において、前記投影光学系が固定される架台(42)に少なくとも一部が設けられ、被計測物体(R, W)に対して計測用ビーム(DL1, DL2)を照射してその位置に関する情報を計測する計測装置(27, 33)と、前記架台に設けられる前記計測装置の少なくとも一部またはその保持部材(43, 48)の温度を調節する温度調節装置(53, 56, 57, 62)を備えたことを特徴とする。

#### 図面の簡単な説明

図1は本発明の実施形態に係る露光装置の全体構成の概略を示す図、  
図2は本発明の実施形態に係る露光装置の要部構成を示す図、  
図3は図2中の矢印A方向から見たレーザ干渉計の近傍の構成を示す図、  
図4aは本発明の実施形態のヒートシンクの構成を示す平面図、  
図4bは本発明の実施形態のヒートシンクの構成を示す側断面図、  
図5は本発明の実施形態の温度制御系の構成を示す図である。

#### 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施形態に係る露光装置について図面を参照して詳細に説明する。図1は本実施形態の投影露光装置の概略構成を示す図である。この露光装置はステップ・アンド・スキャン方式の縮小投影型露光装置である。

尚、以下の説明においては、図1中に示されたXYZ直交座標系を設定し、このXYZ直交座標系を参照しつつ各部材の位置関係について説明する。XYZ直交座標系は、X軸及びY軸が紙面に対して平行となるよう設定され、X軸が紙面に対して垂直となる方向に設定されている。図中のXYZ直交座標系は、実際にはXY平面が水平面に平行な面に設定され、Z軸が鉛直上方向に設定される。

この露光装置11は、照明光源12として、KrFエキシマレーザ(発振波長248nm)を備えている。照明光源12からパルス発光されたレーザビームLBは、ビーム整形光学系13に入射される。ビーム整形光学系13は、シリンダ

レンズやビームエキスパンダ等で構成され、これらにより、後続のフライアイレンズ16に効率よく入射するようにビームの断面形状が整形される。

ビーム整形光学系13から射出されたレーザビームは、エネルギー変調器14に入射される。エネルギー変調器14は、エネルギー粗調器及びエネルギー微調器等から構成されている。エネルギー粗調器は、回転自在なレボルバ上に透過率 $(= (1 - \text{減光率}) \times 100 (\%))$ の異なる複数個のNDフィルタを配置したものであり、そのレボルバを回転することにより、入射するレーザビームLBに対する透過率を100%から複数段階で切り換えることができるようになっている。なお、そのレボルバと同様のレボルバを2段配置し、2組のNDフィルタの組み合わせによってより細かく透過率を調整できるようにしてもよい。一方、エネルギー微調器は、ダブル・グレーティング方式、または傾斜角可変の2枚の平行平板ガラスを組み合わせた方式等で、所定範囲内でレーザビームLBに対する透過率を連続的に微調整するものである。ただし、このエネルギー微調器を使用する代わりに、照明光源12の出力変調によってレーザビームLBのエネルギーを微調整してもよい。

エネルギー変調器14から射出されたレーザビームLBは、光路折り曲げ用のミラー15を介してフライアイレンズ16に入射する。フライアイレンズ16は、後続のレチクルRを均一な照度分布で照明するために多数の2次光源を形成する。なお、オブティカルインテグレータ（ホモジナイザー）としてのフライアイレンズ16を用いる代わりに、ロッドインテグレータ（内面反射型インテグレータ）あるいは回折光学素子等を採用することができる。

フライアイレンズ16の射出面には照明系の開口絞り（いわゆるσ絞り）17が配置されており、その開口絞り17内の2次光源から射出されるレーザビーム（以下、「照明光IL」と呼ぶ）は、反射率が小さく透過率の大きなビームスプリッタ18に入射し、ビームスプリッタ18を透過した照明光ILは、リレーレンズ19、20を介してコンデンサレンズ21へ入射する。

リレーレンズ19とリレーレンズ20との間には、固定スリット板22及び四枚の可動ブラインドを有するレチクルブラインド23が配置されている。固定スリット板22は、矩形の開口部を有し、ビームスプリッタ18を透過した照明光

I Lは、リレーレンズ19を経て固定スリット板22の矩形の開口部を通過するようになっている。この固定スリット板22は、レチクルのパターン面に対する共役面の近傍に配置されている。

レチクルブラインド23はそれぞれ独立して可動する四枚の可動ブラインド（遮光板）を有し、固定スリット板22の近傍に配置されている。走査露光の開始前に可動ブラインド23を移動して適宜な位置に設定し、あるいは走査露光中に可動ブラインドを適宜に移動することにより、不要な部分（レチクルパターンが転写されるウエハW上のショット領域以外）の露光を防止することができるようになっている。

固定スリット板22及びレチクルブラインド23を通過した照明光I Lは、リレーレンズ20及びコンデンサレンズ21を経て、レチクルステージ24上に保持されたレチクルR上の矩形の照明領域を均一な照度分布で照明する。レチクルR上の照明領域内のパターンを投影光学系P Lを介して投影倍率 $\alpha$ （ $\alpha$ は例えば $1/4$ 、 $1/5$ 等）で縮小した像が、フォトリジストが塗布されたウエハ（感光基板）W上に投影露光される。

このとき、レチクルステージ24はレチクルステージ駆動部25によりY方向に走査される。レチクルステージ24の位置は、レチクルステージ24に固定された反射鏡26及びレーザ干渉計等を備えて構成される計測装置27により計測される。走査時には該計測装置27からレチクルステージ24のY座標がステージコントローラ28に供給され、ステージコントローラ28は供給された座標に基づいてレチクルステージ駆動部25を介して、レチクルステージ22の位置及び速度を制御する。なお、図示していないが、反射鏡26はX方向に沿って延びる反射面とY方向に沿って延びる反射面とを有する。そして、X方向に沿って延びる反射面の代わりに、少なくとも1つのコーナーキューブ型ミラーを用いてもよい。

一方、ウエハWは、不図示のウエハホルダを介してウエハステージ29上に載置される。ウエハステージ29は、Zステージ（ウエハテーブル）30と、Zステージ30が載置されるXYステージ31とを有している。XYステージ31は、X軸方向及びY軸方向にウエハWの位置決めを行うとともに、Y軸方向にウエハ



Wを走査する。

Zステージ30は、ウエハWのZ軸方向の位置（フォーカス位置）を調整するとともに、XY平面に対するウエハWの傾斜角を調整する機能を有する。ウエハステージ29の位置は、Zステージ30に固定された反射鏡32及びレーザ干渉計等を備えて構成される計測装置33により計測される。この計測装置33により計測されるウエハステージ29（ウエハW）のX座標、及びY座標がステージコントローラ28に供給され、ステージコントローラ28は、供給された座標に基づいてウエハステージ駆動部34を介してXYステージ31の位置及び速度を制御する。なお、図示していないが、反射鏡32はX方向に沿って延びる反射面とY方向に沿って延びる反射面とを有する。

ステージコントローラ28の動作は、不図示の装置全体を統轄制御する主制御系によって制御されている。そして、走査露光時には、レチクルRがレチクルステージ24を介して+Y軸方向（または-Y軸方向）に速度 $V_R$ で走査されるのに同期して、XYステージ31を介してウエハWは-Y軸方向（又は+Y軸方向）に速度 $\alpha \cdot V_R$ （ $\alpha$ はレチクルRからウエハWに対する投影倍率）で走査される。

Zステージ30上のウエハWの近傍に光電変換素子からなる照度むらセンサ35が常設され、照度むらセンサ35の受光面はウエハWの表面と同じ高さに設定されている。照度むらセンサ35としては、遠紫外で感度があり、且つ照明光ILを検出するために高い応答周波数を有するPIN型のフォトダイオード等が使用できる。照度むらセンサ35の検出信号が不図示のピークホールド回路、及びアナログ／デジタル（A/D）変換器を介して露光コントローラ36に供給されている。

ビームスプリッタ18で反射された照明光ILは、集光レンズ37を介して光電変換素子よりなるインテグレータセンサ38で受光され、インテグレータセンサ38の光電変換信号が、不図示のピークホールド回路及びA/D変換器を介して出力DSとして露光コントローラ36に供給される。インテグレータセンサ38の出力DSと、ウエハWの表面上での照明光ILの照度（露光量）との相関係数は予め求められて露光コントローラ36内に記憶されている。露光コントロー

ラ 3 6 は、制御情報 T S を照明光源 1 2 に供給することによって、照明光源 1 2 の発光タイミング、及び発光パワー等を制御する。露光コントローラ 3 6 は、さらにエネルギー変調器 1 4 での減光率を制御し、ステージコントローラ 2 8 はステージ系の動作情報に同期してレチクルブラインド 2 3 の開閉動作を制御する。

上述した露光装置のレチクルステージ 2 4 やウエハステージ 2 9 では、計測装置 2 7、3 3 の一部を構成する反射鏡 2 6、3 2 はステージ 2 4、3 0 に固定されているものとしたが、ステージの端面を鏡面加工等することにより反射鏡を構成するようにしてもよい。また、反射鏡 3 2 を含む計測装置 3 3 は、図 1 では Y 軸方向の位置を計測するように図示されているが、X 方向にも同様に設けられている。

次に、図 2 を参照して、本実施形態の露光装置の要部構成について説明する。図示は省略しているが、この露光装置は、その主要部（レチクル R、投影光学系 P L、ウエハ W が配置される部分及び照明光学系の一部）が、環境チャンバ（温調チャンバ）内に收容されている。環境チャンバ（図 5 の 5 5）は、天板及び側板を有する箱状体であり、この露光装置が設置されるクリーンルームよりも良好な環境を実現するための装置である。

環境チャンバの内部には架台 4 2 が設けられており、架台 4 2 の水平部（隔壁部）によって、環境チャンバの内部空間が上部空間（レチクル室）と下部空間（ウエハ室）に分割されている。

環境チャンバは塵や埃等の粒子が装置に付着するのを防止するとともに、環境チャンバの内部空間を所定の温度範囲内となるように温度制御する。環境チャンバ内では、通常のクリーンルームよりも精度の高い温度制御がなされており、例えば、クリーンルームの温度制御が $\pm 2 \sim 3^{\circ}\text{C}$ の範囲であるのに対して、環境チャンバ内では $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 程度に保たれる。なお、図示していないが、架台 4 2 は防振機構を介してクリーンルームの床又はフレームキャスタ上に設置される。また、XYステージ 3 1 が配置されるベース部材 4 1 は、不図示の防振機構を介して床又はフレームキャスタ上に配置され、あるいは不図示の固定部材を介して架台 4 2 に吊り下げられている。

架台 4 2 の水平部には貫通穴 4 2 a が形成されており、この貫通穴 4 2 a を貫

通するように、円環状のフランジ部 43a を有する略筒状の支持部材 43 が配置されている。この支持部材 43 は、後述する AF 装置 49, 50 (図 1 では図示省略) を支持するための部材であり、架台 42 に円環状の台座部材 44 を介して取り付けられている。

支持部材 43 には、投影光学系 PL が挿入された状態で固定されている。投影光学系 PL は、その鏡筒の外周部上であって光軸方向の中央部近傍に円環状のフランジ部 45 を有しており、その下側の部分が支持部材 43 内に挿入された状態で、支持部材 43 のフランジ部 43a に円環状の台座部材 46 を介して取り付けられている。

ウエハステージ 29 (ウエハ W) の位置を計測する計測装置 33 (図 1 参照) は、レーザ干渉計 (干渉光学系) 47 を備えており、このレーザ干渉計は、支持部材 48 を介して架台 42 の水平部の下側の所定の位置に位置するように吊り下げられた状態で取り付けられている。支持部材 48 は、図 3 に示されているように、一対の側板 48a 及び下板 48b を有する部材であり、下板 48b の上部にレーザ干渉計 47 が載置・固定されている。尚、このレーザ干渉計 47 は、Y 軸方向の位置計測用のものが示されているが、X 軸方向の位置計測用のレーザ干渉計もこのレーザ干渉計 47 と同様に配置されている。

レーザ干渉計 47 は、波長安定化されたレーザ光源から射出されたレーザビームをビームスプリッタで 2 つに分割し、分割された一方のビーム (検出光) DL1 を Z ステージ 30 の反射鏡 32 に照射し、他方のビーム (参照光) を投影光学系 PL 等の固定部分に設置した参照鏡 (不図示) に照射し、各々反射したビームを干渉させ、その干渉信号から Z ステージの X 軸方向又は Y 軸方向の位置を精密に測定する装置である。

なお、レーザ干渉計 47 の計測精度を向上するため、ほとんど熱膨張しない基準部材の長さを別途隣接して設けられた校正用のレーザ干渉計で計測して、校正用のレーザ干渉計によって計測された基準部材のみかけの寸法と、基準部材の絶対寸法の差に基づいて、計測用のレーザ干渉計の計測結果を補正することにより、光路の屈折率変化による誤差を補償するようにしてもよい。また、この構成のレーザ干渉計に対しても本発明を適用して同様の効果を得るようにしてもよい。

ウエハWの表面の投影光学系P Lの像面に対する合わせ込みを行うためのA F（オートフォーカス）装置は、ウエハWの表面に斜め方向からA F用の検出光D L 2を照射する送光光学系4 9及び該検出光D L 2のウエハWの表面での反射光を受光する受光光学系5 0を備えて構成されている。これらの送光光学系4 9及び受光光学系5 0は、図2に示されているように、支持部材4 3の先端部近傍に取り付けられている。

送光光学系4 9は、赤色又は赤外域に帯域を有するブロードバンドな光を射出する発光部、その他にスリット、レンズ、ミラー、開口絞り等を備えて構成され、スリット状に規定された検出光D L 2をウエハWの表面に対して斜めに投射する。このとき当該スリットの像がウエハW上に結像される。そのスリット像の反射光D L 2は、固定ミラー、レンズ、振動ミラー、角度可変の平行平板ガラス（プレーンパラレル）、検出用のスリット、当該スリットを透過してくるスリット像の光束を光電検出するフォトマルチプライヤ等を備えて構成される受光光学系5 0に入射される。

受光光学系5 0が出力する検波信号は、通常は、ウエハWの表面が投影光学系P Lのベストフォーカスに一致しているときに零レベルとなるように設定されており、その状態からウエハWが光軸A Xに沿って上方へ偏位しているときは正レベルとなり、逆方向に偏位しているときは負レベルとなるようなアナログ信号として出力される。不図示のA F制御装置は、検波信号が零レベルになるように、Zステージ3 0を変位させるアクチュエータを適宜に駆動することにより、ウエハWの自動焦点合わせを行うことができる。

また、この露光装置の環境チャンバは、サイドフロー型の空調系を備えている。この空調系は不図示の送風ダクトが接続された送風口5 1及び排気ダクトが接続された排気口（不図示）を備えて構成され、送風口5 1は、環境チャンバの下部空間（ウエハ室）を構成する部分の上下に渡って配設されており、送風口5 1から投影光学系P Lの光軸に略直交する方向（水平方向）に沿って空気流が吹き出される。なお、本例では環境チャンバの空調系をサイドフロー型としたが、例えばダウンフロー型を用いてもよい。この場合、送風口5 1を架台4 2の下面に設置し、さらに必要に応じて不図示の送風ダクトを分岐して、投影光学系P Lとウ

エハWとの間に空気流を送り込むための送風口を設けてもよい。

この空調装置は、クリーンルーム内に浮遊する異物（ゴミ）、硫酸イオンやアンモニウムイオン等を除去するため、HEPA（またはULPA）フィルター、及びケミカルフィルターを備えており、環境チャンバの内部空間にそのような異物が進入するのが防止されるようになっている。

送風口51から吹き出された空気流は水平方向に流れて、環境チャンバの下部空間の該送風口51に対向する側板の上下に渡って配設された不図示の排気口から外部に排出されるようになっている。

送風口51の近傍には、該送風口51から供給される空気の温度を検出する第1温度センサ52が設けられており、図5に示されているように、第1温度センサ52の検出結果は、マイクロコンピュータ等から構成される温度制御装置53に入力され、温度制御装置53は温度センサ52による検出結果に基づいて、空調装置54を制御し、送風する空気の温度を調整するようになっている。尚、図5において、55は環境チャンバであり、61は送風ダクトである。

図2において、送風口51から送風された空気は、レーザ干渉計47の後方から、該レーザ干渉計47の検出光DL1の光路に沿って流れ、ウエハWと投影光学系PLの間の部分（AF装置49、50の検出光DL2の光路が配置されている）を通過して、不図示の排気口から排出される。排出された空気の大部分は、ケミカルフィルタなどを介して空調装置54に戻され、環境チャンバ55内で循環される。

このとき、例えば、架台42にはプリント回路基板等の発熱体が設置されており、これらからの熱が架台42を介して、レーザ干渉計47の支持部材48やAF装置49、50の支持部材43に回り込むと、これらの支持部材43、48の周囲の温度が高くなり、空調装置54による送風によっても、レーザ干渉計47の検出光DL1の光路やAF装置49、50の検出光DL2の光路上に温度揺らぎが生じてしまうおそれがある。

そこで、この実施形態では、以下のように対策している。即ち、レーザ干渉計47を支持する支持部材48の架台42側の基端部には、図2及び図3に示されているように、複数のヒートシンク（熱交換部材）56が取り付けられている。

この実施形態では、支持部材 48 の一対の側板 48a のそれぞれを挟み込むように、4つのヒートシンクが取り付けられている。

また、AF装置 49, 50を支持する支持部材 43のフランジ部 43aには、複数のヒートシンク 57が取り付けられている。このヒートシンク 57は、フランジ部 43aに所定の角度ピッチで複数取り付けられている。尚、ヒートシンク 57としては、環状に形成された単一のものを採用してもよい。

ヒートシンク 56, 57の構成は、図 4a 及び図 4b に示されている。この実施形態のヒートシンク 56, 57は、全体はアルミや銅等の熱伝導性が良好な材料からなるブロック 58で構成され、その内部に温調液体を流す流路 59が形成されている。ブロック 58には、流路 59内に液体を供給するための液体供給口 58a 及び流路 59内の液体を排出するための液体排出口 58b が形成されている。流路 59内には、金属の発泡体やフィンアレイなどの乱流促進体を兼ねた拡大伝熱体 60が設置されていて、液体とブロック 58との間の熱抵抗を最小にするようになっている。図 4では液体供給口 58a 及び液体排出口 58b が設けられている面と反対の下面が設置面である。

このようなヒートシンク 56, 57の液体供給口 58a 及び液体排出口 58b には、図 5に示されているように、それぞれ液体温調装置 62に接続された配管 63, 64が接続されており、液体温調装置 62から温度調節された液体が供給され、ヒートシンク 56, 57を介して支持部材 43, 48との間で熱交換を行って、液体温調装置 62に戻されるようになっている。循環される液体としては、特に限定されず、例えば、フロリナート（商品名）を採用することができる。

なお、各ヒートシンク 56, 57に対して、液体温調装置 62にそれぞれ並列的に配管を接続して液体を独立的に循環供給するようにしても勿論よいが、各ヒートシンク 56, 57のうちの全部又は一部を直列に配管で接続して液体を一括的に循環供給するようにしてもよい。本実施形態では、支持部材 48についての複数のヒートシンク 56を直列に接続して液体温調装置 62から各ヒートシンク 56に一括的に液体を供給する第1液体循環系と、支持部材 43についての複数のヒートシンク 57を直列に接続して液体温調装置 62から各ヒートシンク 57に一括的に液体を供給する第2液体循環系の2系統を設けている。この場合、液

体温調装置 6 2 は、各系統毎に液体の温度を調整することができる。

各支持部材 4 3, 4 8 には、該支持部材 4 3, 4 8 の温度を検出する第 2 温度センサ 6 5, 6 6 が設けられており、第 2 温度センサ 6 5, 6 6 の検出結果は、温度制御装置 5 3 に入力される。温度制御装置 5 3 は温度センサ 6 5, 6 6 による検出結果に基づいて、液体温調装置 6 2 を制御し、供給する液体の温度を調整するようになっている。尚、温度センサ 6 5 は、支持部材 4 3, 4 8 ではなく、ヒートシンク 5 6, 5 7 に取り付けてもよい。

温度制御装置 5 3 は、送風口 5 1 の近傍に設けられた第 1 温度センサ 5 2 による送風空気の温度が予め決められた所定の温度（例えば、20℃）となるように、空調装置 5 4 を制御するとともに、支持部材 4 8, 4 3 に取り付けられた第 2 温度センサ 6 5, 6 6 による支持部材 4 8, 4 3 の温度が当該所定の温度（20℃）となるように、液体温調装置 6 2 を制御する。

なお、温度制御装置 5 3 による空調装置 5 4 及び液体温調装置 6 2 の制御は、上記に限られず、第 1 温度センサ 5 2 による送風空気の温度が予め決められた所定の温度（例えば、20℃）となるように、空調装置 5 4 を制御するとともに、第 2 温度センサ 6 5, 6 6 による支持部材 5 6, 5 7 の温度が第 1 温度センサ 5 2 による送風空気の温度と一致するように、液体温調装置 6 2 を制御するようである。また、これと反対に、第 2 温度センサ 6 5, 6 6 による支持部材 5 6, 5 7 の温度が予め決められた所定の温度（例えば、20℃）となるように、液体温調装置 6 2 を制御するとともに、第 1 温度センサ 5 2 による送風空気の温度が第 2 温度センサ 6 5, 6 6 による支持部材 4 8, 4 3 の温度と一致するように、空調装置 5 4 を制御するようにしてもよい。

また、送風空気の温度を検出する第 1 温度センサ 5 2 と同様の温度センサをレーザ干渉計 4 7 の検出光 DL 1 の光路の近傍に、あるいは AF 装置 4 9, 5 0 の検出光 DL 2 の光路の近傍に設けて、該当する部分を流れる空気の温度を検出し、これらの検出結果に基づいて、温度制御装置 5 3 によって上記と同様の制御を実施するようにしてもよい。この場合において、検出光 DL 1 の光路の近傍に設けられた温度センサの検出結果に基づいて、液体温調装置 6 2 による前記第 1 液体循環系の液体温度を制御し、検出光 DL 2 の光路の近傍に設けられた温度センサ

の検出結果に基づいて、液体温度調整装置 62 による前記第 2 液体循環系の液体温度を制御するようにできる。即ち、支持部材 48 と支持部材 43 のそれぞれの温度を独立的に制御するようにできる。

なお、図 2 において、68 は架台 42 のウェハ室側の面に取り付けられた断熱部材であり、架台 42 の露出面からウェハ室に熱が放出されることを防止するために設けられている。

本実施形態によると、送風口 51 からの送風空気、即ち、支持部材 43, 48 の周囲の温度と支持部材 43, 48 の温度がほぼ一致することになり、レーザ干渉計 47 の検出光 DL1 の光路や AF 装置 49, 50 の検出光 DL2 の光路に温度揺らぎ（屈折率の動的変化）が発生することが少なくなる。従って、レーザ干渉計 47 や AF 装置 49, 50 の検出値の精度を向上することができる。

これにより、ウェハ W の XY 方向の位置決めや走査移動、その表面の投影光学系 PL の像面への合わせ込み等を厳密に行うことができるので、ウェハ W 上に転写形成されるパターンの精度を向上することができ、ひいては高性能で高信頼なマイクロデバイス等を製造することができるようになる。

なお、以上説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするために記載されたものであって、本発明を限定するために記載されたものではない。従って、上記の実施形態に開示された各要素は、本発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも含む趣旨である。

上述した実施形態では、支持部材 43, 48 の温度を調整する温度調節装置として、液体温度調整装置 62 及びヒートシンク 56, 57 を備えたものについて説明しているが、支持部材 43, 48 を冷却（又は加熱）することができる装置であればよく、例えば、ペルチェ効果を利用して発熱又は吸熱するペルチェ素子を用いることができる。上述したヒートシンクによるものと、ペルチェ素子を組み合わせたものを用いてもよい。

また、上述した実施形態では、環境チャンバの架台 42 の水平部よりも下部のウェハ室について、本発明を適用した例を説明したが、レチクルステージ 24 の位置を計測するための計測装置 27 のレーザ干渉計の検出光の光路についても、温度揺らぎによる同様な問題が生じ得るので、上部のレチクル室についても同様



に本発明を適用することが望ましい。また、レチクルRはそのパターン面の投影光学系P Lの光軸方向の位置や傾斜量などがウエハWと同様に計測されることがあり、例えば前述のA F装置4 9, 5 0と同一構成のA F装置、あるいはレーザ干渉計などが用いられるので、同様に本発明を適用することが望ましい。さらにX Yステージ3 1が配置されるベース部材4 1が架台4 2とは分離して設けられる場合、架台4 2（投影光学系P L）とZステージ3 2との相対位置関係（投影光学系の光軸方向の間隔など）を検出するために、例えば架台4 2の下面に設置した反射面と、Zステージ3 0に4 5度で斜設した反射面とにレーザビームを照射するレーザ干渉計などが用いられるので、同様に本発明を適用することが望ましい。また、ウエハ上のアライメントマークなどを検出するオフアクシス方式のアライメント系は、特に光学系の少なくとも一部が金物などによって架台4 2に固定されるので、同様に本発明を適用することが望ましい。さらに、前述の実施形態では温度制御した空気をレーザ干渉計などの光路に送るものとしたが、例えば窒素あるいはヘリウムなどの不活性ガスを、その温度や圧力などを調整してウエハ室またはレチクル室などに供給する、即ちその内部を不活性ガスでパージする場合でも、同様に本発明を適用することが望ましい。

上述した実施形態では、環境チャンバの内部に供給する気体を空気であるものとして説明したが、他の気体であってもよい。特に、光源として遠紫外光を射出するものを用いるような場合には、空気中の酸素による吸収を防止するため、窒素又はヘリウムを用いることが望ましい。

上述した実施形態では、ステップ・アンド・スキャン方式の縮小投影型露光装置に本発明を適用したものを説明したが、ステップ・アンド・リピート方式又はステップ・アンド・スティッチ方式の縮小投影型露光装置やミラープロジェクション・アライナーなど、いかなる方式の露光装置に対しても適用することが可能である。

また、半導体素子や液晶表示素子の製造に用いられる露光装置だけでなく、プラズマディスプレイ、薄膜磁気ヘッド、及び撮像素子（CCDなど）、マイクロマシン、DNAチップなどの製造に用いられる露光装置、及びレチクル又はマスクを製造するために、ガラス基板又はシリコンウエハなどに回路パターンを転写

する露光装置にも本発明を適用できる。即ち、本発明は、露光装置の露光方式や用途等に関係なく適用可能である。

上述した実施形態では露光用光源として、波長が248nmのKrFエキシマレーザを用いるものとしたが、これに限定されず、g線（波長436nm）、i線（波長365nm）、ArFエキシマレーザ（波長193nm）、F<sub>2</sub>レーザ（波長157nm）、Ar<sub>2</sub>レーザ（波長126nm）等を採用することができる。また、X線（EUV光を含む）、あるいはイオンビームや電子線などの荷電粒子線を用いることもできる。さらに、YAGレーザ又は半導体レーザなどの高調波発生装置などを用いてもよい。例えば、DFB半導体レーザ又はファイバーレーザから発振される赤外域、又は可視域の単一波長レーザを、エルビウム（又はエルビウムとイットリビウムの両方）がドープされたファイバーアンプで増幅し、さらに非線形光学結晶を用いて紫外光に波長変換した高調波を用いてもよい。尚、単一波長発振レーザとしてはイットリビウム・ドープ・ファイバーレーザを用いる。

F<sub>2</sub>レーザを光源とする露光装置では一例として、照明光学系や投影光学系に使われる屈折光学部材（レンズエレメント）は全て蛍石とされ、環境チャンバ、照明光学系、及び投影光学系内の空気は、例えばヘリウムガスで置換される。また、レチクルは、蛍石、フッ素がドープされた合成石英、フッ化マグネシウム、LiF、LaF<sub>3</sub>、リチウム・カルシウム・アルミニウム・フロライド（ライカフ結晶）又は水晶等から製造されたものが使用される。

投影光学系は縮小系のみならず等倍系あるいは拡大系のいずれでもよい。さらに、投影光学系は屈折系のみならず反射屈折系あるいは反射系のいずれでもよい。

本実施形態の露光装置は、複数のレンズから構成される照明光学系、投影光学系を露光本体部に組み込み光学調整をするとともに、多数の機械部品からなるレチクルステージや基板ステージを露光本体部に組み込んで配線や配管を接続し、レーザ干渉計やAF装置を組み込んでその支持部材にヒートシンクや温度センサを取り付けて配管や配線を接続した上で光学調整し、別途空調装置を有する環境チャンバを組み立てて、当該露光本体部を当該環境チャンバ内に設置し、さらに総合調整（電気調整、動作確認等）をすることにより、製造することができる。

なお、露光装置の製造は温度及びクリーン度等が管理されたクリーンルーム内で行うことが望ましい。

本発明の実施形態に係る露光装置を用いてデバイス（ＩＣやＬＳＩ等の半導体チップ、液晶パネル、ＣＣＤ、薄膜磁気ヘッド、マイクロマシン等）を生産するには、まず、設計ステップにおいて、デバイスの機能設計（例えば、半導体デバイスの回路設計等）を行い、その機能を実現するためのパターン設計を行う。引き続き、マスク製作ステップにおいて、設計した回路パターンを形成したマスクを製作する。一方、ウエハ製造ステップにおいて、シリコン等の材料を用いてウエハを製造する。

次に、ウエハプロセスステップにおいて、上記ステップで用意したマスクとウエハを使用して、リソグラフィ技術によってウエハ上に実際の回路等を形成する。次いで、組立ステップにおいて、ウエハプロセスステップにおいて処理されたウエハを用いてチップ化する。この組立ステップには、アッセンブリ工程（ダイシング、ボンディング）、パッケージング工程（チップ封入）等の工程が含まれる。最後に、検査ステップにおいて、組立ステップで作製されたデバイスの動作確認テスト、耐久性テスト等の検査を行う。こうした工程を経た後にデバイスが完成し、これが出荷される。

本発明によると、支持部材の温度と該支持部材が存在する周辺空間の温度をほぼ一致させることができるので、露光装置に備わるレーザ干渉計やＡＦ装置等の検出装置に当該温度揺らぎによる誤差を生じることが少なくなり、マスクの位置決め、基板の位置決めや姿勢制御、あるいはマスクと基板の同期移動を高い精度で行うことができるようになる。これにより、微細パターンを高精度で転写形成することができ、性能や信頼性の高いマイクロデバイス等を製造することができるようになるという効果がある。

本開示は、２０００年１２月２７日に提出された日本国特許出願第２０００－３９７２１３号に含まれた主題に関連し、その開示の全てはここに参照事項として明白に組み込まれる。

### 請 求 の 範 囲

1. 計測光学系を介して被計測物体に対して計測用の光ビームを出射して該被計測物体の位置に関する情報を計測する計測装置と、  
前記計測光学系を支持する支持部材と、  
前記支持部材の温度を調節する温度調節装置とを備えた露光装置。

2. 前記温度調節装置は、  
前記支持部材に取り付けられる熱交換部材と、  
前記熱交換部材の内部を通過するように温度調節された流体を循環させる循環装置とを有する請求項1に記載の露光装置。

3. 前記光ビームの光路を含む空間に温度調節された気体の流れを生成する空調装置と、

前記空調装置による気体の温度と前記支持部材の温度とが一致するように、前記温度調節装置及び前記空調装置の少なくとも一方を制御する制御装置とをさらに備えた請求項1又は2に記載の露光装置。

4. 前記計測装置は、パターンが形成されたマスク又は露光対象としての基板を投影光学系の光軸に直交する面内で移動するステージの位置を計測するレーザ干渉計である請求項1, 2又は3に記載の露光装置。

5. 前記計測装置は、露光対象としての基板の表面の投影光学系の光軸に沿う方向の位置を計測するフォーカスセンサである請求項1, 2又は3に記載の露光装置。

6. 第1物体に照射される照明光を第2物体上に投射する投影光学系を備えた露光装置において、

前記投影光学系が固定される架台と、

前記架台に少なくとも一部が設けられ、被計測物体に対して計測用ビームを照射してその位置に関する情報を計測する計測装置と、

前記計測装置の前記架台に設けられた部分または当該部分を保持する保持部材の温度を調節する温度調節装置を備えた露光装置。



**FIG. 2**

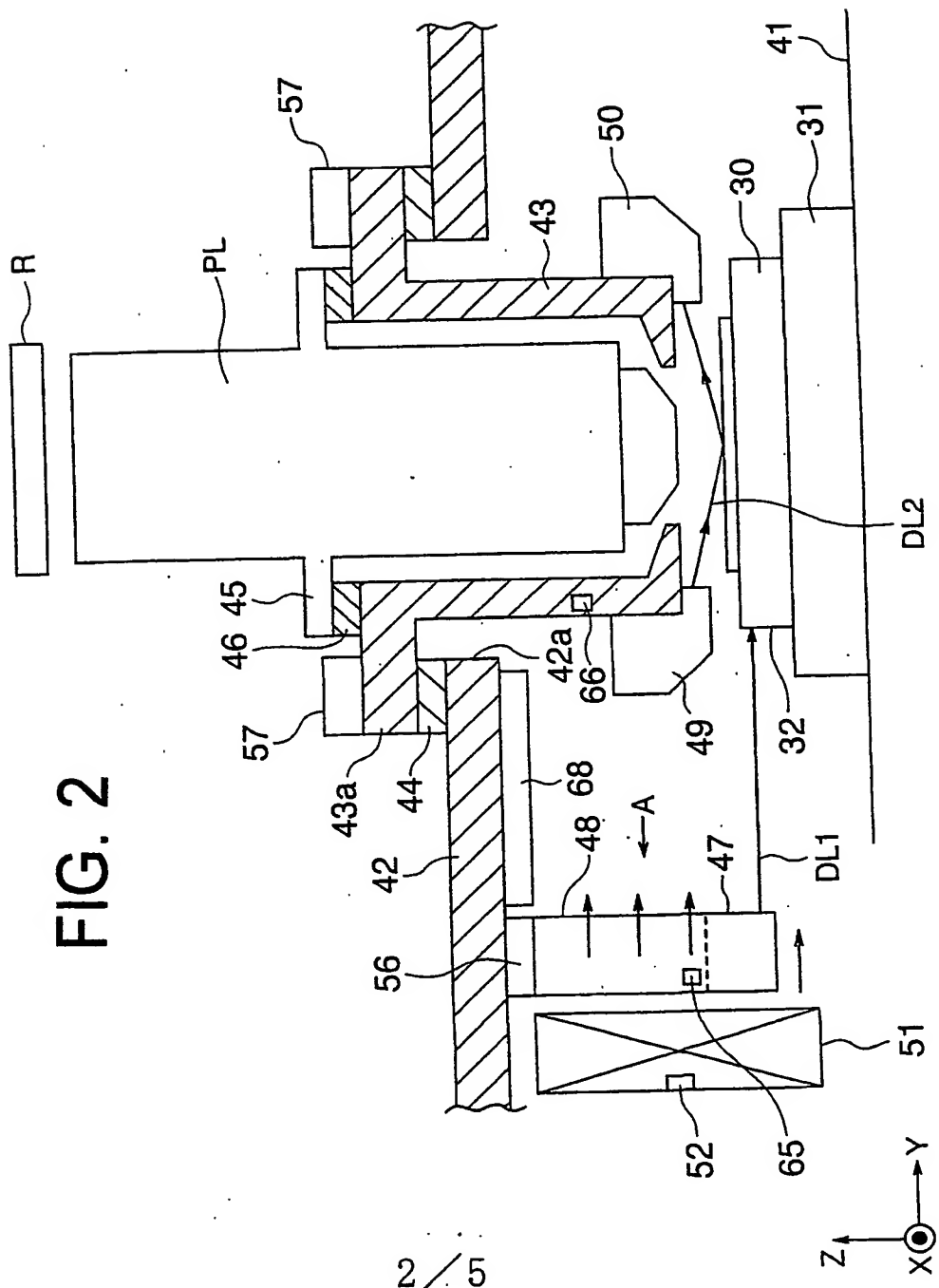


FIG. 3

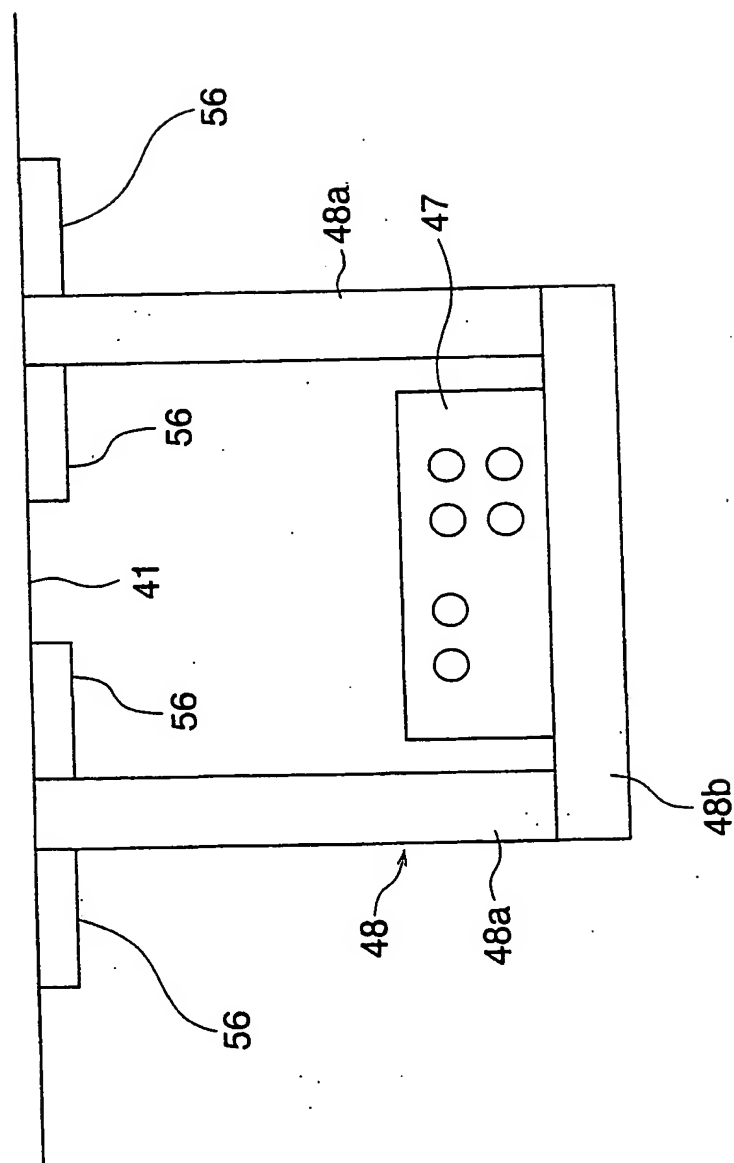


FIG. 4a

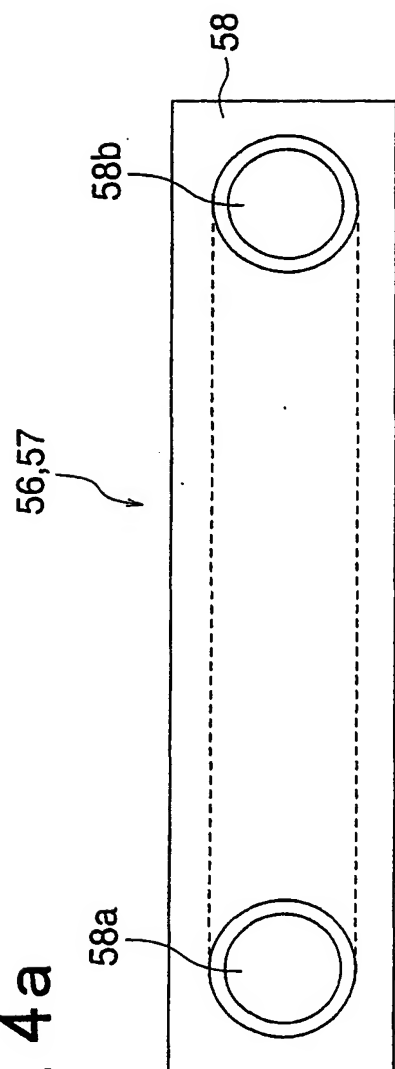


FIG. 4b

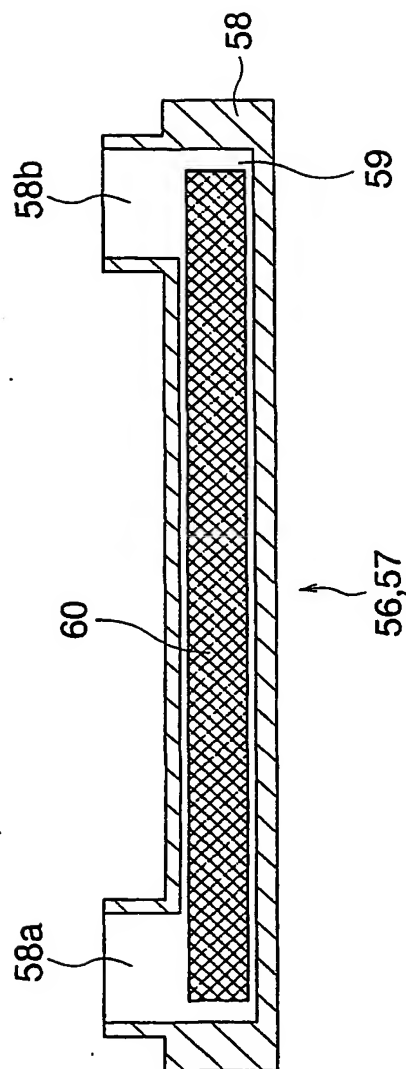
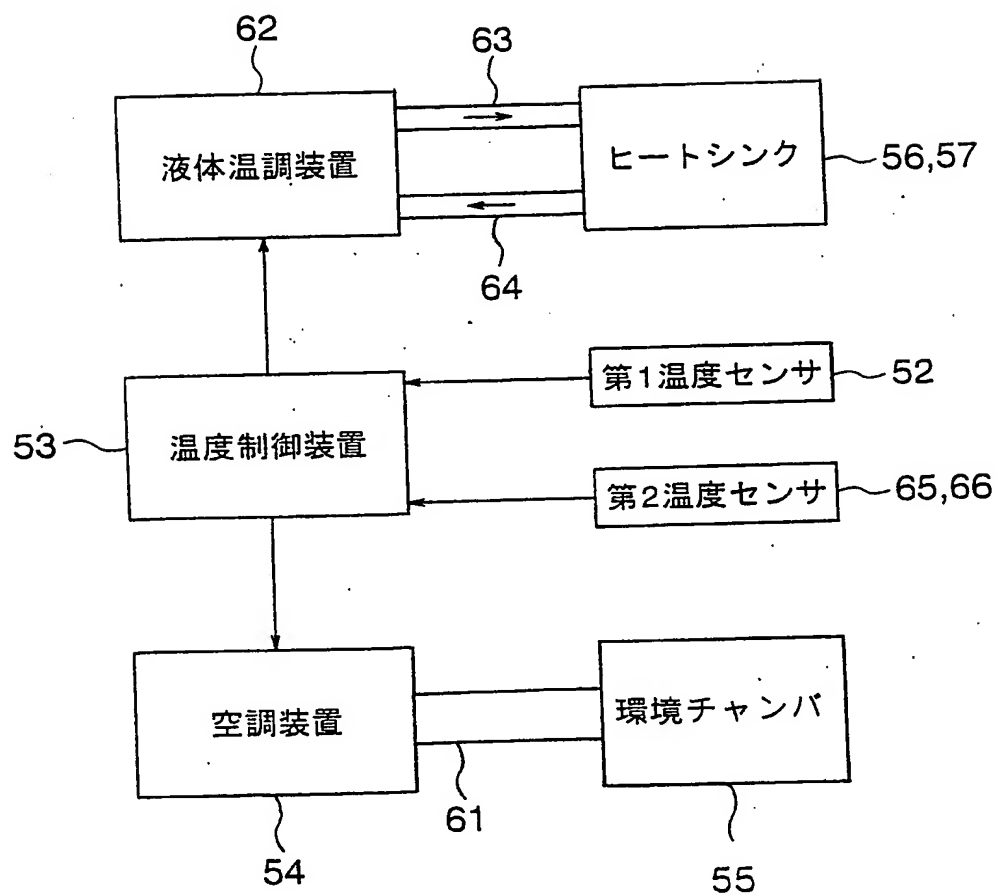




FIG. 5



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/11454

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
Int.Cl.<sup>7</sup> H01L21/027

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
Int.Cl.<sup>7</sup> H01L21/027

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  
Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2002  
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2002 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2002

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 09-320927 A (Nikon Corporation), 12 December, 1997 (12.12.1997), Full text; all drawings & KR 97017959 A & US 5877843 A	1-2, 4-6
Y		3
Y	JP 09-283432 A (Nikon Corporation), 31 October, 1997 (31.10.1997), Full text; all drawings (Family: none)	3

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family
---	--

Date of the actual completion of the international search  
25 February, 2002 (25.02.02)

Date of mailing of the international search report  
05 March, 2002 (05.03.02)

Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> H01L21/027

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> H01L21/027

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年  
 日本国公開実用新案公報 1971-2002年  
 日本国登録実用新案公報 1994-2002年  
 日本国実用新案登録公報 1996-2002年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	J P 09-320927 A (株式会社ニコン) 1997. 1 2. 12、全文、全図 &KR 97017959 A &US 5877843 A	1-2, 4-6
Y		3
Y	J P 09-283432 A (株式会社ニコン) 1997. 1 0. 31、全文、全図 (ファミリーなし)	3

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

- 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの  
 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの  
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献  
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの  
 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  
 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの  
 「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

25. 02. 02

国際調査報告の発送日

05.03.02

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)  
 郵便番号100-8915  
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

南 宏 輔

2M

2911

電話番号 03-3581-1101 内線 3274

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**